PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-189031

(43)Date of publication of application: 10.07.2001

(51)Int.CI.

G11B 7/135 G02B 1/10 G02B 3/00 G02B 5/08 G02B 5/32 G02B 17/08 G11B 7/004 G11B 7/125 G11B 7/13 H01L 31/10 H01S 5/028 H01S 5/14

(21)Application number: 2000-252553

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(22) Date of filing:

23.08.2000

(72)Inventor: KAMIYANAGI KIICHI

(30)Priority

Priority number: 11300523

Priority date: 22.10.1999

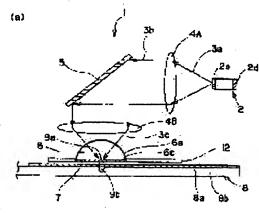
Priority country: JP

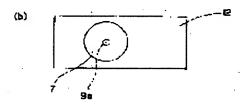
(54) OPTICAL HEAD AND OPTICAL DISK UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head and an optical disk unit having the stable reproduction output over the using temperature range, with which the S/N ratio of the reproduced signal becomes high and the high recording density of the optical disk is obtainable, in the case the signal is reproduced by using the self-combination effect of a semiconductor laser.

SOLUTION: A resonator of the semiconductor laser is constituted of a high reflection film 2d on the rear end surface of an activated medium 2 for semiconductor laser and a reflecting/transmitting film 7 formed on the surface 6c to be converged of a transparent medium 6 for convergence. The reflecting/ transmitting film 7 is provided with a transmittance such that the intensity difference of the signals detecting the lights returned from a recording medium 8a is increased in accordance with the recorded information of the recording medium 8a. Thus, the reproduced signal having the high S/N ratio is obtained even though a light spot 9a is made smaller.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-189031

(P2001-189031A) (43)公開日 平成13年7月10日(2001.7.10)

(51) Int. Cl	. 7	識別記号		F	FΙ	• 4			テーマコート。	(参考)
GIIB	7/135				G11B	7/135		A	2HO42	•
								Z	2H049	
G02B	1/10				G02B	3/00		В	2Н087	
	3/00					5/08		Z	2K009	
	5/08		•.			5/32			5D090	
				審査請求	未請求	請求項の数26	OL	(全19]	頁) 最終頁	こ続く

	審査請求	未請求 請求	関の数26	OL	(全19頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-252553(P2000-252553)	(71)出願人	00000549	_	14 - b A + i	
(22)出願日	平成12年8月23日(2000.8.23)	(72)発明者	富士ゼロ 東京都港 上柳 喜	区赤坂	株式会社 二丁目17番21	2号
(31)優先権主張番号	特願平11-300523	(12)光明省	神奈川県	足柄上		30 グリーン
(32)優先日 (33)優先権主張国	平成11年10月22日(1999.10.22) 日本 (JP)	(74)代理人	テクなか 10007152		土ゼロックス	株式会社内
•			弁理士	平田	忠雄	

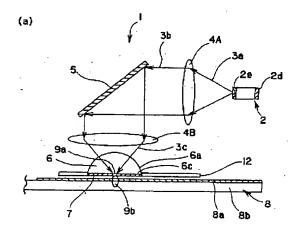
最終頁に続く

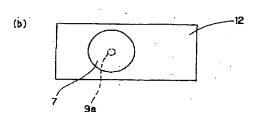
(54) 【発明の名称】 光ヘッドおよび光ディスク装置

(57)【要約】

【課題】 半導体レーザの自己結合効果を用いて信号を再生する場合に、再生信号のSN比が高く、光ディスクの高記録密度化が可能で、使用温度範囲わたって再生出力の安定な光ヘッドおよび光ディスク装置を提供する。

【解決手段】 半導体レーザ活性媒体2の後端面の高反射膜2dと透明集光用媒体6の被集光面6cに形成された反射透過膜7とにより半導体レーザの共振器を構成する。反射透過膜7は、記録媒体8aからの戻り光を検出した信号の強度差が記録媒体8aの記録情報に応じて大きくなるような透過率を有する。これにより、光スポット9aを小さくしてもSN比の高い再生信号が得られる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】後端面に髙反射膜を有し、前端面に反射防 止膜を有して前記前端面からレーザ光を出射する半導体 レーザ活性媒体と、

前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射された 前記レーザ光を集光して被集光面上に光スポットを形成 する透明集光用媒体と、

前記透明集光用媒体の前記被集光面に形成され、所定の 透過率を有して前記半導体レーザ活性媒体の前記高反射 膜との間で半導体レーザの共振器を構成するとともに、 前記被集光面上に形成された前記光スポットを前記所定 の透過率に応じて透過させて記録媒体に前記レーザ光を 入射させる反射透過膜と、

前記記録媒体に入射した前記レーザ光の戻り光に基づい て前記半導体レーザ活性媒体が発振する状態を検出する 検出器とを備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項2】前記反射透過膜が有する前記所定の透過率 は、前記記録媒体の記録情報に応じた光強度を有する前 記戻り光の検出により前記検出器から出力される検出信 号の強度差がほぼ最大となるように設定される構成の請 20 求項1記載の光ヘッド。

【請求項3】前記反射透過膜が有する前記所定の透過率 は、10%以上を有する構成の請求項1記載の光ヘッ ۲.

【請求項4】前記反射透過膜は、金属膜、誘電体多層 膜、あるいは超解像膜から形成された請求項1記載の光 ヘッド。

【請求項5】前記透明集光用媒体は、0.8以上の開口 数を有し、前記被集光面に直径 0.2μm以下の前記光 スポットを形成する構成の請求項1記載の光ヘッド。

【請求項6】前記透明集光用媒体は、半球状あるいは裁 底球状を有し、球面部を前記入射面とし、底面部を前記 被集光面とする構成の請求項1記載の光ヘッド。

【請求項7】前記透明集光媒体は、屈折率分布型マイク ロレンズから構成され、前記屈折率分布型マイクロレン ズの底面部を前記被集光面とする構成の請求項1記載の 光ヘッド。

【請求項8】前記透明集光用媒体は、前記入射面に入射 した前記レーザ光を反射させて前記被集光面に前記光ス ポットを形成する反射面を有し、

前記反射面は、回転放物面の一部、あるいは回転楕円面 の一部から構成され、前記反射面の表面に反射体が形成 された請求項1記載の光ヘッド。

【請求項9】前記透明集光用媒体は、前記入射面に入射 した前記レーザ光を反射させて前記被集光面に前記光ス ポットを形成する反射面を有し、

前記反射面は、平面から構成され、前記反射面の表面 に、前記入射面に入射した前記レーザ光を集光する集光 作用を有する反射型ホログラムが形成された請求項1記 載の光ヘッド。

【請求項10】前記透明集光用媒体は、前記入射面の表 面に、前記入射面に入射した前記レーザ光を集光する集 光作用を有する透過型ホログラムが形成された請求項1 記載の光ヘッド。

【請求項11】後端面に高反射膜を有し、前端面に反射 防止膜を有して前記前端面からレーザ光を出射する半導 体レーザ活性媒体と、

前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射された 前記レーザ光を集光して被集光面上に光スポットを形成 する透明集光用媒体と、

前記透明集光用媒体の前記被集光面の集光位置に所定の サイズの開口を有し、前記半導体レーザ活性媒体の前記 高反射膜との間で半導体レーザの共振器を構成するとと もに、前記被集光面上に形成された前記光スポットから 前記開口を通して記録媒体に前記レーザ光を入射させる 反射遮光膜と、

前記記録媒体に入射した前記レーザ光の戻り光に基づい て前記半導体レーザ活性媒体が発振する状態を検出する 検出器とを備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項12】前記透明集光用媒体は、0.8以上の開 口数を有することを特徴とする請求項11記載の光ヘッ

【請求項13】前記光スポットは、0.2 μm以下の直 径を有することを特徴とする請求項11記載の光ヘッ

【請求項14】前記開口は、前記透明集光用媒体あるい は高屈折率透明媒体により埋め込まれていることを特徴 とする請求項11記載の光ヘッド。

【請求項15】前記反射遮光膜の前記開口は、前記記録 媒体の記録情報に応じた光強度を有する前記戻り光の検 30 出により前記検出器から出力される検出信号の強度差が ほぼ最大となるような前記所定のサイズを有する構成の 請求項11記載の光ヘッド。

【請求項16】前記反射遮光膜の前記開口は、前記光ス ポットの直径よりも小さい円形状を有する構成の請求項 11記載の光ヘッド。

【請求項17】前記反射遮光膜の前記開口は、前記光ス ポットの直径よりも小さい矩形状を有し、それぞれの辺 は前記記録媒体上の記録トラックに直交する方向、ある いは平行な方向に形成された構成の請求項11記載の光 40 ヘッド。

【請求項18】前記反射遮光膜の前記開口は、矩形状を 有し、長手方向の辺が前記光スポットの直径よりも長 く、短手方向の辺が前記光スポットの直径よりも短く、 かつ、前記長手方向の辺が前記記録媒体上の記録トラッ クに直交する構成の請求項11記載の光ヘッド。

【請求項19】前記透明集光用媒体は、半球状あるいは 裁底球状を有し、球面部を前記入射面とし、底面部を前 記被集光面とする構成の請求項11記載の光ヘッド。

【請求項20】前記透明集光用媒体は、屈折率分布型マ

イクロレンズから構成され、前記屈折率分布型マイクロレンズの底面部を前記被集光面とする構成の請求項11記載の光ヘッド。

【請求項21】前記透明集光用媒体は、前記入射面に入射した前記レーザ光を反射させて前記被集光面に前記光スポットを形成する反射面を有し、

前記反射面は、回転放物面の一部、あるいは回転楕円面の一部から構成され、前記反射面の表面に反射体が形成された請求項11記載の光ヘッド。

【請求項22】前記透明集光用媒体は、前記入射面に入 10 射した前記レーザ光を反射させて前記被集光面に前記光 スポットを形成する反射面を有し、

前記反射面は、平面から構成され、前記反射面の表面 に、前記入射面に入射した前記レーザ光を集光する集光 作用を有する反射型ホログラムが形成された請求項11 記載の光ヘッド。

【請求項23】前記透明集光用媒体は、前記入射面の表面に、前記入射面に入射した前記レーザ光を集光する集 光作用を有する透過型ホログラムが形成された請求項1 1記載の光ヘッド。

【請求項24】後端面に高反射膜を有し、前端面に反射防止膜を有して前記前端面からレーザ光を出射する半導体レーザ活性媒体と、

前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射された 前記レーザ光を集光して被集光面に光スポットを形成す る透明集光用媒体と、

前記透明集光用媒体の前記被集光面の集光位置に所定のサイズの開口を有するとともに、前記透明集光用媒体側の面が、前記半導体レーザ活性媒体からのレーザ光が反射して前記半導体レーザ活性媒体に戻らないように傾斜面あるいは凹凸面を有する反射遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッド。

【請求項25】記録媒体を有する光ディスクと、前記光ディスクの前記記録媒体上にレーザ光を集光させて光スポットを形成し、この光スポットの照射により記録および再生を行う光ヘッドを有する光ディスク装置において、

前記光ヘッドは、

後端面に高反射膜を有し、前端面に反射防止膜を有して 前記前端面からレーザ光を出射する半導体レーザ活性媒 40 体と、

前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射された 前記レーザ光を集光して被集光面上に光スポットを形成 する透明集光用媒体と、

前記透明集光用媒体の前記被集光面に形成され、所定の 透過率を有して前記半導体レーザ活性媒体の前記高反射 膜との間で半導体レーザの共振器を構成するとともに、 前記被集光面上に形成された前記光スポットを前記所定 の透過率に応じて透過させて前記記録媒体に前記レーザ 光を入射させる反射透過膜と、 前記記録媒体に入射した前記レーザ光の戻り光に基づいて前記半導体レーザ活性媒体が発振する状態を検出する 検出器とを備えたことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項26】記録媒体を有する光ディスクと、前記光ディスクの前記記録媒体上にレーザ光を集光させて光スポットを形成し、この光スポットの照射により記録および再生を行う光ヘッドを有する光ディスク装置において、

前記光ヘッドは、

) 後端面に高反射膜を有し、前端面に反射防止膜を有して 前記前端面からレーザ光を出射する半導体レーザ活性媒 体と、

前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射された 前記レーザ光を集光して被集光面上に光スポットを形成 する透明集光用媒体と、

前記透明集光用媒体の前記被集光面の集光位置に所定の サイズの開口を有し、前記半導体レーザ活性媒体の前記 高反射膜との間で半導体レーザの共振器を構成するとと もに、前記被集光面上に形成された前記光スポットから 前記開口を通して前記記録媒体に前記レーザ光を入射さ せる反射遮光膜と、

前記記録媒体に入射した前記レーザ光の戻り光に基づいて前記半導体レーザ活性媒体が発振する状態を検出する 検出器とを備えたことを特徴とする光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

【発明の属する技術分野】本発明は、光ヘッドおよび光ディスク装置に関し、半導体レーザの自己結合効果を用いて信号を再生する場合に、再生信号のSN比が高く、光ディスクの高記録密度化が可能で、使用温度範囲わたって再生出力の安定な光ヘッドおよび光ディスク装置に関する。

[0002]

【従来の技術】光ディスクを高記録密度化するための記録・再生方式の一つに、半導体レーザの自己結合効果を用いる方式が知られている。この方式は、半導体レーザの出力光が光ディスクの記録媒体で反射し、その一部が半導体レーザに再入射した場合に、その反射光の強度により半導体レーザの発振状態が変調されることを利用し、その変調度合いを検出することにより、記録媒体の記録情報を再生するものである。この変調度を大きくりと、不多でであることが可能となることができ、本方式は、高密度記録に有望な方式と言える。また、この半の反射光の有無に係わらず発振させることができ、そのレーザ光を使用して記録することが可能となる。

【0003】この基本形の従来の光ヘッドとして、例えば、文献I(H.Ukita, Tech. Digestof ODS '91, TuC2-1, (1991) P. 130.) に示されるものが

4

ある。

【0004】この光ヘッドは、半導体レーザの後端面に 設けた髙反射膜と光ディスクの記録媒体のみにより共振 器を構成する方式を用いたものであり、後端面に髙反射 膜を設けた半導体レーザと、半導体レーザの後に集積さ れ、半導体レーザが変調された時の出力変動を検出する フォトダイオードとを備え、半導体レーザの出力側をテ ーパ状のリッジにより絞ることにより、出力レーザビー ムの径を細くしている。しかし、絞り過ぎるとレーザの 発振閾値が大幅に増加するため、光スポット径を約1μ 10 m径程度とするのが限界であり、記録マークもその程度 となるため、現DVDの規格のマークサイズ(0.45 μm長)に比べても大きく、このままでは、高記録密度 化はできない。

【0005】これに対し、微小開口を有する高反射遮光 膜を共振器の一方のミラーとして用い、その微小開口か ら漏れ出す微小のレーザ光を記録再生に使用する方式が 提案されている。

【0006】この方式を用いた従来の光ヘッドとして、 例えば、文献II(A.Partovi, Tech.Digest of ISOM/ODS '99, ThC-1,(1999) P.352.)に示されるものがある。こ の光ヘッドは、0.25 µmの微小開口を有する高反射 膜を半導体レーザの出力端面に設けたものである。これ により、光スポット径を0.25 µmに微小化できる。 【0007】また、半導体レーザの出力光を他の光学系・ を介して記録媒体に照射して、その反射光を用いて自己 結合型の検出を行う方式としては、例えば、文献III(Mi crooptics News (日本語)、Vol.16, No.4, (1998) P.17、特開2000-48393号公報)、文献IV (特開平11-259894号公報)、文献Va (Appl.P hys. Lett., Vol. 63 (26), (1993) p. 3550)、文献Vb(US P5,389,779(1995))、および文献VI(Jpn. J.Appl.Ph ys, , Vol. 37, (1998) p. 3759, 0 plus E Vol. 20(2), (19 98) p. 193) に示されるものがある。

【0008】図22は、上記文献IIIに記載された光へ ッドを示す。この光ヘッド50は、透明集光用媒体の出 力面に上記微小開口を有する遮光膜を設けたものであ り、半導体レーザ51と、半導体レーザ51からのレー ザ光を平行ビームに整形するコリメータレンズ52と、 コリメータレンズ52からの平行ビームを集光するセル 40 フォックレンズ53と、セルフォックレンズ53の出力 面に設けられた微小開口54aを有する遮光膜54と、 半導体レーザ51の出力光を検出するホトダイオード5 5とを有する。この構成により、半導体レーザ51から 出射されたレーザ光は、セルフォックレンズ53により 遮光膜54の微小開口54a部に集光され、その一部が 微小開口から近接場光の光スポット57として記録媒体 5 6 a に 照射されて、記録を行う。 再生時には、記録媒 体56aからの反射戻り光の一部が再度微小開口54a

1の光強度ないしインピーダンスを変調し、それらを検 出することにより、再生信号が形成される。

【0009】図23は、微小開口54aのサイズと光出 力の関係を示す。上記光ヘッドによると、同図から明ら かなように、微小開口54aのサイズ0.25μmまで 小さくすることができ、光ディスク56の記録媒体56 a上に約0.25μmの微小の光スポット57を形成す ることができる。

【0010】図24は、上記文献IVに記載された光ヘッ ドを示す。この光ヘッドは、半導体基板70a上に形成 された活性層70bを有してレーザ光を半導体基板70 aに対して水平に出射する端面発光型半導体レーザ70 と、端面発光型半導体レーザ70の後方に設けられたフ オトダイオード71と、端面発光型半導体レーザ70お よびフォトダイオード71を支持する支持基板72と、 端面発光型半導体レーザ70から出射されたレーザ光を 90度曲げるプリズム73と、プリズム73で反射し、 対物レンズ74を介して入射したレーザ光を被集光面7 5 a に集光するソリッドイマージョンレンズ 7 5 とを有 する。対物レンズ74およびソリッドイマージョンレン ズ75は、透明光学ガラスあるいは半導体からなる基板 76にフォトリソグラフィ技術とドライエッチングとに よって形成されて、この基板76上にプリズム73およ び支持基板72が固定されている。端面発光型半導体レ ーザ7.0からのレーザ光をソリッドイマージョンレンズ 75の被集光面75aに集光させ、そこから放射される 伝播光や、染み出す近接場光を記録媒体56 aに照射す ることにより記録を行い、再生時には記録媒体56aか らの反射戻り光をソリッドイマージョンレンズ75によ り再び集光して半導体レーザ70に再入射させることに より、やはりレーザの発振特性を変調してその変調度を フォトダイオード71により検出して再生信号を形成す

【0011】図25は、文献Va、Vbに記載された光ヘッ ドを示す。この光ヘッドは、Cavity - SNOM (Scanning N ear-field Optical Microscopy) と称されるテーパー型 のプローブの先端とレーザの裏面のミラーを用いて共振 器(Cavity)を構成し、そのプロープ先端に近接して試 料を走査することにより、試料上の情報を、自己結合効 果を用いて検出するものであり、裏面にミラー80aを 備え、その後方に光検出器81が配置されたレーザ80 と、レーザ80から出射されたレーザ光を集光する対物 レンズ82と、対物レンズ82からのレーザ光を先端8 5まで導く光ファイバ83とを有する。光ファイバー8 3は、一部にレーザ活性材料 (Nd原子など) がドープ され、テーパー型に研磨されたテーパー部84を有し、 その先端85は波長以下のサイズに狭められている。レ ーザ80から対物レンズ82を介して光ファイバー83 に入射したレーザ光は、その先端85から近接場光を試 を通して半導体レーザ51に再入射し、半導体レーザ550料86に照射し、その反射光を用いてレーザ80に自己

結合効果を生じさせる。試料86からの情報収集は、こ の光ファイバ83のテーパー部84を試料86上に走査 させながら、反射光の強度変化によるレーザ80の出力 変化を光検出器81で検出することにより行う。

【0012】上記文献VIに記載された光ヘッドは、文献 Va、Vbに示す光ヘッドと基本構成は同等であるが、レー ザ活性媒体として、半導体レーザを使用している点が、 文献Va、Vbに示す光ヘッドと異なる。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記文献IIに 示された光ヘッドによると、半導体レーザ内のレーザビ ームの直径は通常2~3μmと大きいため、半導体レー ザの出力端面に設けた高反射膜の微小開口の直径を高記 録密度化に実際的に意味のある 0. 1 μ m程度にする と、両者の面積比は数百分の一となり、微小開口からの 戻り光による変調度の割合はそれ以上に低くなり、十分・ な信号強度を得ることができず、0.25μmの微小開 口が記録可能な限界となるため、光スポット径を0.1 μm以下にすることはできず、光ディスクの高記録密度 化が実現できないという問題がある。

【0014】上記文献IIIに示された光ヘッドによる と、透明集光用媒体としてセルフォックレンズ53を用 いているため、実質的にはレーザ光のビーム径を半導体 レーザ51の出力端面のそれよりも小さくすることはで きず、 $2 \sim 3 \mu m$ 程度の直径までにしか収束できない。 このため、そのレンズ53の出力端面に微小開口54a を有する高反射膜54を設けても、文献11に示された光 ヘッドに比べて微小開口54aから放出されるレーザ光 の割合を増すことはできず、戻り光により十分に半導体 レーザ51を変調できず、再生信号のSN比が低いとい 30 う問題がある。

【0015】上記文献IIIおよび文献IVに記載された光 ヘッドは、いずれも再生信号出力が安定しないという問 題がある。すなわち、両者の場合、半導体レーザ51と 遮光膜54や被集光面75aとの光路の間に、コリメー タレンズ52やプリズム73、集光媒体(53,75) などが入るため、その光路長は1mm以下にすることは 困難である。この光路長が温度により変動し、それによ って戻り光の位相が、半導体レーザ内の発振光の位相に 対して変化する。そのために、ある一定強度の戻り光が 40 とされ、DVDなどで使用されるパルス幅(数十ns) 半導体レーザに入射しても、位相が一致した場合には、 レーザ光強度が増加し、反転した場合には、減少する。 光ディスク装置の場合、使用温度は0~80度までと広 く、また、光素子の膨張係数は、10-6のオーダーであ るため、その距離変動は1 0 mm tab 5 1 μmの オーダーとなる。一方、位相が反転するまでの距離は、 1/2波長に相当し、赤色(650nm)の場合、0. 33μ m、青色レーザ(400nm)の場合は、0.2μmと、上記の光路長変動に対してはるかに小さな値で

る。これを抑えるには、温度調節や熱膨張の補正を行う 必要があり、装置が大きくなる、高価となるなど現実的 ではない。

【0016】上記文献Va、Vbに記載された光ヘッドは、 テーパー部84での光損失が大きいために共振器損失が 非常に大きくなる。本従来例では、テーパー部84の先 端85径を150nmと比較的大きくしているが、それ でも反射率は4%であり、96%が損失となっている。 このために、パワー効率が悪く、本従来例では、Kェイ オンレーザによる光励起によりレーザ発振を行ってお り、装置が大型となる。また、テーパー部84の先端8 5径をこの種の装置として意味のある50 nm以下とす ると、さらに損失が増大する。すなわち、文献VII (Dig esl of Optical Data Storage 1996, OWA1-1, p. 2 14) に示されるように、開口50nmでは、透過率は、 0.01%以下であり、残りの大半が、先端85周辺の 金属膜によって吸収され、この先端85を加熱すること になる。文献VIII (Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 35 (1 996) p. 443) に示されているように、12mW以 上のレーザ光をテーパー型プローブに入射すると、プロ ープ先端部が溶解する。また、それ以下のパワーでも、 先端部の輻射熱により、試料を加熱するという問題があ る。これらの問題から、この型の光ヘッドは、文献Vaに あるように、近接場顕微鏡として試料からの情報検出に は使用できても、光記録に使用することはできない。 【0017】上記文献Vbでは、レーザ光源として半導体

レーザを使用する例も提案されているが、この場合も高 出力を必要とすることには変りない。そのような従来例 としては、文献VIに示す例がある。この例では、半導体 レーザを使用して信号再生のみを行っているが、その場 合でも、殆ど再生信号が得られていない。また、信号再 生のみでレーザの注入電流は50mA以上必要であり、 消費電力としては100mW以上となり、パワー効率が 悪いと共に、加熱により光ヘッドを歪ませるなどの問題 が生じる。さらに、本従来例のように相変化媒体に光記 録しようとすると、再生に必要なパワーの数倍が必要で あり、文献VIIIで示される例では、パルス幅5msとい うDVDなどに比べても1万倍以上長いパルス幅のレー ザ光を使用しても、記録パワーとして8mW以上が必要 ではワットクラスのレーザパワーが必要となり非現実と なる。以上、詳述したように、開口などにより微小な近 接場光を形成して、それにより光記録・再生を行う場 合、消費電力を抑えて記録に必要な近接場光の強度を確 保するためには、共振器の光損失を減らし、レーザ発振 の効率を上げなければならず、テーパー型ファイバを用 いた共振器は光記録には不向きである。一方、再生に半 導体レーザの自己結合効果を利用する場合、戻り光によ るレーザ発振の変調度を大きくするためには、共振器内 あり、温度により再生出力が大きく変動することが分か 50 のレーザ光に対する戻り光の強度比をある程度大きくす

る必要があり、共振器損失には最適値が存在する。上記 した従来の自己結合効果を用いた光ヘッドでは、このよ うな最適化は図られていない、あるいは不可能であっ た。

【0018】従って、本発明の目的は、半導体レーザの 自己結合効果を用いて信号を再生する場合に、再生信号 のSN比が高く、光ディスクの高記録密度化が可能な光 ヘッドおよび光ディスク装置を提供することにある。ま た、本発明の他の目的は、使用温度範囲わたって再生出 力の安定な光ヘッドおよび光ディスク装置を提供するこ 10 とにある。

[0019]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するため、後端面に高反射膜を有し、前端面に反射防 止膜を有して前記前端面からレーザ光を出射する半導体 レーザ活性媒体と、前記半導体レーザ活性媒体の前記前 端面から出射された前記レーザ光を集光して被集光面上 に光スポットを形成する透明集光用媒体と、前記透明集 光用媒体の前記被集光面に形成され、所定の透過率を有 して前記半導体レーザ活性媒体の前記高反射膜との間で 20 半導体レーザの共振器を構成するとともに、前記被集光 面上に形成された前記光スポットを前記所定の透過率に 応じて透過させて記録媒体に前記レーザ光を入射させる 反射透過膜と、前記記録媒体に入射した前記レーザ光の 戻り光に基づいて前記半導体レーザ活性媒体が発振する 状態を検出する検出器とを備えたことを特徴とする光へ ッドを提供する。上記構成によれば、記録媒体からの戻 り光を検出した信号の強度差が記録媒体の記録情報に応 じて大きくなるように反射透過膜が有する所定の透過率 を設定すれば、光スポットの径を小さくしてもSN比の 30 高い再生信号が得られる。

【0020】本発明は、上記目的を達成するため、後端 面に高反射膜を有し、前端面に反射防止膜を有して前記 前端面からレーザ光を出射する半導体レーザ活性媒体 と、前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射さ れた前記レーザ光を集光して被集光面上に光スポットを 形成する透明集光用媒体と、前記透明集光用媒体の前記 被集光面の集光位置に所定のサイズの開口を有し、前記 半導体レーザ活性媒体の前記高反射膜との間で半導体レ ーザの共振器を構成するとともに、前記被集光面上に形 40 成された前記光スポットから前記開口を通して記録媒体 に前記レーザ光を入射させる反射遮光膜と、前記記録媒 体に入射した前記レーザ光の戻り光に基づいて前記半導 体レーザ活性媒体が発振する状態を検出する検出器とを 備えたことを特徴とする光ヘッドを提供する。上記構成 によれば、記録媒体からの戻り光を検出した信号の強度

 $D_{i/i} = k \cdot \lambda / (n \cdot NA i)$

ここに、kは比例定数でガウスビームの場合は、約0. 5 であり、λは入射レーザ光の波長、nは透明集光用媒 体6の屈折率、NAiは透明集光用媒体6内部での開口 50 対物レンズ4BのNAに等しい。記録に際しては、記録

差が記録媒体の記録情報に応じて大きくなるように反射 反射膜の開口のサイズを設定すれば、光スポットの径を 小さくしてもSN比の高い再生信号が得られる。

【0021】本発明は、上記目的を達成するため、後端 面に高反射膜を有し、前端面に反射防止膜を有して前記 前端面からレーザ光を出射する半導体レーザ活性媒体 と、前記半導体レーザ活性媒体の前記前端面から出射さ れた前記レーザ光を集光して被集光面に光スポットを形 成する透明集光用媒体と、前記透明集光用媒体の前記被 集光面の集光位置に所定のサイズの開口を有するととも に、前記透明集光用媒体側の面が、前記半導体レーザ活 性媒体からのレーザ光が反射して前記半導体レーザ活性 媒体に戻らないように傾斜面あるいは凹凸面を有する反 射遮光体とを備えたことを特徴とする光ヘッドを提供す る。上記構成によれば、半導体レーザ活性媒体は、記録 媒体からの戻り光によりレーザ発振のオンオフを行うた め、SN比の大きな信号が得られる。

[0022]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施の形 態に係る光ヘッドを示す。同図(a)は、光ヘッドの側 面図、同図(b)は底面図である。この光ヘッド1は、 半導体レーザ活性媒体2と、半導体レーザ活性媒体2か らの誘導放出光3aを平行ビーム3bに整形するコリメ ータレンズ4Aと、コリメータレンズ4Aからの平行ビ ーム3bをほぼ直角に折り曲げるフォールディングミラ ー5と、フォールディングミラー5からの平行ビーム3 bを集光する対物レンズ4Bと、対物レンズ4Bから入 射される収束ビーム3cを集光して底面である被集光面 6 c 上に光スポット9 a を形成する透明集光用媒体 6 と、透明集光用媒体6の被集光面6cの表面に形成さ れ、被集光面6 a 上に形成された光スポット9 a から光 ディスク8の記録媒体8 aに近接場光スポット9 bを照 射する反射透過膜7と、少なくとも対物レンズ4B、フ ォールディングミラー5、透明集光用媒体6および反射 透過膜7を支持し、光ディスク8上を浮上走行する浮上 スライダ12とを有する。

【0023】透明集光用媒体6は、ここでは、ソリッド ・イマージョン・レンズ (Solid Immersion Lens: S I L)と称される半球状のものを用いており、収束ビーム 3 c が屈折せずに垂直に入射する半球面状の入射面 6 a と、収束ビーム3cが集光して光スポット9aが形成さ れる被集光面6 c とを有する。

【0024】被集光面6c上の光スポット9aの直径D 1/1 (光強度が1/2となる位置の直径)は、次式 (2) で与えられる。

..... (2)

数であり、本実施の形態では透明集光用媒体6としてS ILを使用しており、入射面6aでの屈折がないため、

【0025】図2は、半導体レーザ活性媒体2を示す。 半導体レーザ活性媒体2は、n型GaAs基板2aと、 基板2a上に形成された活性層2bと、活性層2b上に 形成されたp型GaAs層2cと、後端面に形成された 高反射膜2dと、出力側端面に形成された反射防止膜2 eと、使用時には逆バイアスが印加される活性部電極2 f、光検出部電極2gおよびn型電極2hとを備え、半 導体レーザ活性媒体2の後端面に形成された高反射膜2 dと透明集光用媒体6の被集光面6cに形成された反射 透過膜7との間で半導体レーザの共振器を構成し、活性

それに伴い、記録再生密度を上げることができる。

$$P = C \cdot (G / (L + (T - R)^{-} - 1)) \cdot (T - R)$$
 (2)

ここに、Tは反射透過膜7の透過率、Gは一往復当りの利得、Lは一往復当りの共振器の内部損失、Cは定数である。

【0028】反射透過膜7は、上記式(1)の光出力Pの戻り光があるときの最大値と戻り光がないときの最小値の差が最も大きくなるような透過率Tが得られるように、材料および厚さを選定すればよい。反射透過膜7の材料としては、例えば、銀(Ag)薄膜や他の金属膜、SiO,とCeO,等の薄膜を重ねた誘電体多層膜、光強度に依存して透過率が非線型に変化する、多光子吸収膜や可飽和吸収膜等のいわゆる超解像膜等を用いることができる。誘電体多層膜を用いた場合は、吸収の少ないので、式(1)から分かるように、変調度を大きく取るこ40とができる。超解像膜を用いた場合は、光スポット9aの中心部の光強度の高い部分のみを出射させることができ、これによって出力レーザ光を絞ることができ、さらに高記録密度化が可能となる。

【0029】次に、SN比の高い再生信号が得られる理由を図3を参照して説明する。上記式(1) から分かるように、利得と損失(L+(T-R)) が等しくなったところで発振が開始、すなわち閾値に達し、その後は近似的には直線的に増加する。図3において、曲線Aは、反射戻り率Rが大きい場合、Bは小さい場合を示し、

部電極2 f と n 型電極2 h 間に順方向に電流を印加することにより活性層2 b に T レーザ発振を行って反射透過膜7を通して近接場光スポット9 b を 出力し、光検出部電極2 g と n 型電極2 h との間の光検出部2 x によって半導体レーザ活性媒体2 の発振状態を検出するものである。

【0026】反射透過膜7は、所定の透過率を有するものが用いられる。以下、それについて図面を参照して説明する。

10 【0027】図3は、半導体レーザ活性媒体2への注入電流とレーザ出力の関係を示す。また、同図は、半導体レーザの共振器の出力端である反射透過膜7での光損失をパラメータとして示している。記録媒体8 aから戻り光がある場合は、等価的に光損失が低下するため、半導体レーザの共振器の正味損失は、反射透過膜7の透過膜7の透り率」とは、出力光に対し、記録媒体8 aで反射した後、半導体レーザ活性媒体2に再入射する戻り光の光強度比をいう。この反射戻り率は、実際には、共振器内での位20 相に対する戻り光の位相ずれを考慮する必要があるが、記録媒体8 a との距離が波長の数分の一と小さく、また、変動も少ないため、その位相ずれを一定として、位相ずれを考慮した等価的な反射戻り率をRとすると、この半導体レーザの光出力Pは、次式(1)で近似できる。

C, Dは従来例の図20に示すセルフォックレンズ53 の出力面に開口54aを有する高反射膜54を用いた場 30 合を示す。この図から分かるように、いずれの場合も注 入電流が小さい場合は、レーザ発振は行われず、曲線E を辿って僅かに光出力が増大する。この光出力の大部分 は自然放出光であり、注入電流が増大するにつれて誘導 放出光の割合が増加し、やがてレーザ発振の閾値に至 る。反射戻り率Rが大きい場合(A)は、小さい注入電 流で、低い場合(B)は、大きい注入電流でレーザ発振 の閾値に至る。両者の閾値差が大きいため、その中間の 電流値dの電流を注入することにより、戻り光の強度の 大小により、曲線A、B間でオンオフ変調ができ、S/ Nを高くとることができる。従来の開口を用いた場合 (C, D)は、高反射膜54による反射が大きいため、 共振器の損失(L+(T-R)が小さくなり、閾電流値 は低いが、透過率Tが小さいため、同図に示すように、 反射戻り率Rが大きい場合(C)と、小さい場合(D) との差が小さくなり(原理的にR>T)、オンオフ変調 が難しくなる。 【0030】実際には、半導体レーザ活性媒体2のGa

100307 美際には、手導体レーサ活性操体2のGa AlInPなどの活性層2bの単位長さ当りの利得は、 0~300cm¹程度で注入電流とともに増加し、光損 50 失αは10cm¹であり、活性層2bの長さは0.03

c m程度であるため、利得Gは $0\sim9$ 、損失は0.3となる。戻り光と半導体レーザ活性媒体2とのカプリング効果を高めるためには、反射透過膜7の透過率は10%以上と高いほうがよく、反射透過膜7の透過率を例えば50%に設定すると、利得G=0.8でレーザ発振を開始する。

【0031】光ディスクとしては、DVD-ROMなどの再生専用型光ディスクや、書き換え型の相変化光ディスクを用いることができる。

【0032】光ディスクとして再生専用型光ディスクを 10 用いた場合は、その記録マークの髙反射部での反射率は 80%と高いため、この戻り光のある場合には、反射透 過膜7の損失は、0.06程度となり、閾値利得は0. 36程度と戻り光のない場合の半分以下となる(この場 合の閾値電流値は一般的に10~20mAである)。こ のため、高反射時の閾値電流値aと低反射時の閾値電流 値 b とは 2 倍以上の差となる。従って、再生時の電流値 をりよりも十分低い電流値dに設定することにより、光 ディスクの記録マークの高反射部でのみ発振し、記録マ ークの低反射部ではレーザ発振せず、矢印eに示すよう にレーザ発振のオンオフ変調がなされるので、大きな信 号出力が得られ、S/Nを高めることができる。一方、 従来の微小開口の例では、開口の透過率は、0.01以 下であり、反射光が100%変調されたとしても、高反 射時と低反射時の光損失はそれぞれ0.3と0.31程 度の差しかなく、殆ど変調度が取れない。

【0033】光ディスクとして書き換え型の相変化光ディスクを用いた場合は、結晶部とアモルファス部の反射率はそれぞれ0.3と0.1程度であるので、それぞれの場合の全損失は0.45と0.35程度となり、その30差は0.1とROMの場合の数分の一となるが、閾値電流値にして3mA以上の差が取れるので、十分な信号再生ができる。また、相変化ディスクの記録時には、閾値電流値りよりも十分大きな電流値fにおいてマークを形成することになり、戻り光の有無の差を吸収して安定してマーク形成を行うことができる。

【0034】次に、この光ヘッド1の再生動作を説明する。半導体レーザ活性媒体2から誘導放出光3aを出射すると、その誘導放出光3aは、コリメータレンズ4Aによって平行ビーム3bに整形され、フォールディング 40ミラー5によってほぼ直角に折り曲げられた後、対物レンズ4Bによって集光されて透明集光用媒体6の入射面6aに入射する。透明集光用媒体6に入射した収束ビーム3cは、透明集光用媒体6により集光され、被集光面6cに光スポット9aを形成する。被集光面6cに形成された光スポット9aは、反射透過膜7から近接場光スポット9bとして漏れ出し、光ディスク8の記録媒体8aに入射し、記録媒体8a上に形成された記録マークを照射する。光ディスク8の記録媒体8aの記録状態に応じて記録媒体8aからの戻り光の強度が異なる。記録媒 50

体8 a 上の記録マークに照射された近接場光スポット9 b は、記録マークで反射しその戻り光は、照射時と逆の経路を辿り、反射透過膜7を透過して半導体レーザ活性媒体2に入射する。この戻り光による半導体レーザ活性媒体2の自己結合効果により、光ディスク8からの戻り光の強度に応じて半導体レーザ活性媒体2が発振する。戻り光の強度が大きい場合と小さい場合の中間の電流値を注入電流として設定してあるので、半導体レーザ活性媒体2の光検出部2xは、半導体レーザ活性媒体2の発振状態を検出し、光検出部電極2gから検出信号を出力する。

【0035】上述した第1の実施の形態によれば、微小 な光スポット9aが得られるとともに、再生時にレーザ のオンオフ変調ができるため、S/Nの高い信号再生が 可能となり、ひいては高密度記録が可能となる。なお、 透明集光用媒体 6 としてスーパーソリッド・イマージョ ン・レンズ(Super Solid Immersion Lens: S-SIL) と称される裁底球状で、かつ、中心からr/n(rは半 径、nは媒体屈折率)の底面に被集光面を有するものを 用いてもよい。これにより、本実施の形態と同様の効果 が得られる。この場合、入射面で屈折するため、透明集 光用媒体内部での開口数NAiをさらに高められるた め、より微小径の光スポットが得られ、さらに高記録密 度化ができる。また、本実施の形態では、半導体レーザ の共振器の出力面である反射遮光膜7を記録媒体8 a に 近接できるため、戻り光の位相が対物レンズ4A, 4 B、フォルディングミラー5、透明集光用媒体6等の光 素子の熱膨張の影響を受けないため、温度変動に対して 安定な信号再生が可能となる。

【0036】図4は、本発明の第2の実施の形態に係る光ヘッドを示す。同図(a)は側面図、同図(b)は底面図である。なお、同図において、Xはトラック方向を示し、Yはトラック方向Xに直交する方向を示す。この第2の実施の形態は、第1の実施の形態の反射透過膜7の代わりに、微小の開口10aを有する反射遮光膜10を用いたものであり、半導体レーザ活性媒体2の後端面の高反射膜2dと反射遮光膜10との間で共振器が構成されている。開口10aのサイズは、光スポット9aの直径よりも小さく、例えば、幅0.1 μ mの矩形状を有する。

【0037】このように構成された第2の実施の形態によれば、透明集光用媒体 6 として微小な光スポット9 a が得られるSILを用いているため、反射遮光膜10上での光スポット9 a の径は0.2 μ m以下にでき、開口10 a のサイズを0.1 μ mとした場合、両者の面積比は0.25 となり、近接場光スポット9 b はほぼガウス型の強度分布を有するため、中心部にパワーが集中しており、従って開口10 a の実質透過率は、0.5 程度と第1の実施の形態と同程度にでき、従って反射光とレーザとのカプリング効率も同様に高められ、S/Nの高い

再生信号が得られる。すなわち、第1の実施の形態と同様に、再生信号の高S/N化が図れ、従来困難であった 高密度記録再生が可能となる。

【0038】なお、開口10aは光スポット9aの直径よりも小さい円形でもよい。また、開口10aのサイズは、 0.1μ m以下にすることも可能であり、それによりさらに高記録密度化を図ることができる。また、図4(c)に示すように、矩形の開口10aのトラック方向Xと直交する方向Yを近接場光スポット9bの直径よりも大きくしてもよい。これにより、戻り光と半導体レー 10 が活性媒体2のカプリング効率を大きくできるので、トラック方向Xの開口幅を狭めることができ、実質的に記録密度を本実施の形態と同程度にできるとともに、近接場光スポット9b0をトラック方向Xに直交する方向Yに走査できるので、それを用いて高速のトラッキングを行うことができる。

【0039】図5は、本発明の第3の実施の形態に係る 光ヘッドを示す。この第3の実施の形態は、透明集光用 媒体6として平板状のものを用いたものであり、透明集 光用媒体6は、平行なレーザビーム3bが入射する入射 20 面6aと、入射面6aに対向する位置に設けられた被集 光面6cを有し、入射面6aに、平行ビーム3bを集光 する透過型のホログラム11を配置し、被集光面6cの 表面に反射透過膜7を配置したものである。この第3の 実施の形態によれば、開口数0.8以上の集光が可能で あるので、第1の実施の形態と同様の効果が得られる。 【0040】図6は、本発明の第4の実施の形態に係る 光ヘッドを示す。この第4の実施の形態は、透明集光用 媒体6として回転放物面型のものを用い、コリメータレ ンズ4Aの出力ビーム3bを直接この透明集光用媒体6 30

【0041】透明集光用媒体6は、平行ビーム3bが入射する入射面6aと、入射面6aに入射した平行ビーム3bを反射する反射面6bと、反射面6bからの収束光3cが集光し、光スポット9aが形成される被集光面6cとを有し、反射面6bの表面には金属等からなる反射膜13が形成されている。反射面6bは、透明集光用媒体6内部での収束光3cの収束角を大きくし、被集光面6cに微小の光スポット9aを形成するため、回転放物40面の一部からなる。回転放物面の断面の主軸をX軸に、垂直軸をZ軸に採り、焦点位置Fの座標を(p,0)、高さをzとすると、断面は、

に入射している点が第1の実施の形態と異なり、他は第

1の実施の形態と同様に構成されている。

$z^1 = 4 p x$

と表される。また、回転放物面を用いてその焦点に集光する場合、原理的に無収差の集光が可能であり(光学: 久保田、岩波書店、P. 283)、単一の集光面6bにより微小の光スポット9aを形成することが可能になる。この場合の光スポット9aの直径 $D_{1/1}$ は、次式で与えられる。

ここに、kは比例定数でガウスビームの場合は約0.5であり、λは入射レーザ光の波長、nは透明集光用媒体6の屈折率、NAiは透明集光用媒体6内部での開口数

 $D_{i/i} = k \cdot \lambda / (n \cdot NAi)$

である。本実施の形態では、半導体レーザ活性媒体2として、赤色発光(630nm)のGaInP系媒体を使用し、NAiは0.8とした。

【0042】上述した第4の実施の形態によれば、反射 透過膜7上での光スポット径は、第1の実施の形態と同 様に0.2 μm以下となり、第1の実施の形態と同様の 高記録密度化が可能となる。また、この透明集光用媒体 6の高さについては、加工上の問題以外に特に制限はな く、0.5 mmにすることも可能であることから、光へ

ッド1のサイズを磁気ヘッドと同程度に小型化できる。 なお、透明集光用媒体6の反射面6bを回転楕円面の一 部から構成してもよい。これにより、回転放物面を用い た透明集光用媒体と同様の効果が得られる。

【0043】図7は、本発明の第5の実施の形態に係る 光ヘッドを示す。この第5の実施の形態は、図6に示す 第4の実施の形態の透明集光用媒体6の入射面6aを凸 状にしたものである。凸状の入射面6aは、コリメータ レンズの役割を果たすので、コリメータレンズ4Aを省 略することができる。

【0044】図8は、本発明の第6の実施の形態に係る 光ヘッドを示す。この第6の実施の形態は、第4の実施 の形態において、回転楕円面の反射面6bの一方の焦点 F1を入射面6a上に形成し、他方の焦点F2を被集光面 6c上に形成し、図6のコリメータレンズ4Aを省略 し、入射面6aに半導体レーザ活性媒体2の出力面を当 接し、入射面6a上の焦点F1と半導体レーザ活性媒体 2の出力位置を一致させたものである。この第6の実施 の形態によれば、部品点数が減らせるとともに、光ヘッ ドの組み立て調整が簡素化でき、小型化を図ることがで きる。

【0045】図9は、本発明の第7の実施の形態に係る 光ヘッドを示す。この第7の実施の形態は、断面三角形 状の透明集光用媒体6を用い、透明集光用媒体6の反射 面6bの表面に、集光作用を有する反射型のホログラム 11を配置したものであり、他は第4の実施の形態と同 様に構成されている。反射型のホログラム11として は、バイナリホログラムでもボリュームホログラムでも よい。この第7の実施の形態によれば、反射面6bを平 坦にできるため、透明集光用媒体6の加工性を高くでき

【0046】図11は、本発明の第9の実施の形態に係る光ヘッドを示す。この第9の実施の形態は、第1の実施の形態の形態において、対物レンズ4B、および半球状の透明集光用媒体6の代わりにカタディオプティック(Catadioptic)型の透明集光用媒体6を使用したもの

50 である。この透明集光用媒体6は、平行なレーザビーム

18

3 bが入射する凹球面状の入射面6 aと、入射面6 aに 対向する位置に設けられた被集光面6cと、入射面6a の周囲に形成された非球面状の反射面6 b とを有し、非 球面状の反射面6 b の表面に、反射膜13を形成したも のである。この第9の実施の形態によれば、第1の実施 の形態と同様の効果が得られるとともに、対物レンズが 不要であることから、小型化が可能となる。なお、反射 膜13の代わりに反射型のホログラムを用いてもよい。 【0047】図12(a), (b)は、本発明の第10 の実施の形態に係る光ヘッドを示す。この第10の実施 10 の形態は、透明集光用媒体6としてS-SILを用いた ものであり、その被集光面6c上には、微小の開口10 aを有する反射遮光膜10が形成されている。また、反 射遮光膜10は、同図(a)に示すように、上面10b が凸型の円錐面状を有する。これにより、反射遮光膜1 0の上面10bに照射した光ビーム3dは反射するが、 その反射光3 c は半導体レーザ活性媒体2 に戻らず、開 口10aを通過したレーザ光のみが戻るため、S/N比 を向上させることができる。なお、透明集光用媒体6 は、他の実施の形態のものを用いてもよい。また、反射 20 遮光膜10の上面10bは、同一方向に傾斜した面でも よい、凹型の円錐面状でもよく、同図(b)に示すよう に、細かい凹凸を形成してもよい。

【0048】なお、第1~第10の実施の形態におい て、半導体レーザ活性媒体2中に、複数の活性層2b、 活性部電極2fおよび光検出部電極2gを十数μmない し30μm程度の間隔で平行に配置することにより、複 数の近接場光スポット9bを発生させるようにしてもよ い。これにより、これらの複数の近接場光スポット9 b を複数のトラック上をトラッキングさせることにより、 複数のトラックに対して同時に記録再生を行うことが可 能となり、高転送レート化が達成できる。また、第3~ 第9の実施の形態において、反射透過膜7の代わりに第 2の実施の形態と同様に微小の開口10aを有する反射 遮光膜10を用いてもよい。これにより、第2の実施の 形態と同様の効果が得られる。

【0049】図13は、本発明の第11の実施の形態に 係る光ディスク装置20を示す。この光ディスク装置2 0は、円盤状のアルミニウム基板122の一方の面に記 録層121が形成され、モータ22の回転軸221を介 40 して回転する光ディスク120と、光ディスク120の 記録層121に対して記録再生を行う第4の実施の形態 と同様に構成された光ヘッド1と、光ヘッド1を光ディ スク120の内外周にわたってアクセスし、かつ、トラ ッキングさせるリニアモータ23と、リニアモータ23 側から光ヘッド1を支えるスイングアーム24と、光へ ッド1を駆動する光ヘッド駆動系25と、光ヘッド1に レーザ駆動信号を送り、かつ、光ヘッド1からの信号を 処理する信号処理系26とを有する。なお、光ディスク

けでなく、Siや表面研磨を施したポリカーボネイト等 を使用してもよい。

【0050】信号処理系26は、光ヘッド1に設けられ た半導体レーザ活性部の光検出部が検出した光ディスク 120からの戻り光に基づいてトラッキング制御用の誤 差信号およびデータ信号を生成し、誤差信号はハイパス フィルタとロウパスフィルタによって高周波域と低周波 域の誤差信号に分け、これらの誤差信号に基づいて光へ ッド駆動系25に対してトラッキング制御をさせるもの である。ここでは、トラッキング用の誤差信号をサンプ ルサーボ方式(光ディスク技術、ラジオ技術社、P. 9 5) によって生成するようになっており、このサンプル サーボ方式は、千鳥マーク(Wobbled Mark)を間欠的にト ラック上に設け、それらからの戻り光の強度変化から誤 差信号を生成するものである。また、トラッキング制御 は、低周波の誤差信号に基づいてスイングアーム24駆 動用のリニアモータ23を制御し、髙周波の誤差信号に 基づいてビーム走査型の半導体レーザ活性媒体2を制御 しする2段制御方式となっており、低周波から髙周波ま での精密なトラッキングを可能としている。サンプルサ ーボの場合、記録信号とトラッキング誤差信号とは時分 割的に分離されているので、両者の分離は再生回路にお けるゲート回路により行う。

【0051】図14は、光ヘッド1を示し、同図(a) はその側面図、同図(b)はその平面図である。光ヘッ ド1は、光ディスク120上を浮上走行する浮上スライ ダ31を有し、この浮上スライダ31の上に、半導体レ ーザ活性媒体2と、半導体レーザ活性媒体2からの誘導 放出光3aを平行光ビーム3bに整形するコリメータレ ンズ4Aと、半導体レーザ活性媒体2を支持する石英板 32と、コリメータレンズ4Aからの平行光ビーム3b を集光する回転放物面からなる反射面6 b を有する透明 集光用媒体6と、透明集光用媒体6の反射面6bの表面 にAlなどの金属で蒸着形成された反射膜13とを配置 している。透明集光用媒体6の被集光面6cの表面に、 図4 (c) と同様のスリット状の開口10aを有する反 射遮光膜10を配置している。また、全体はヘッドケー ス36内に収納され、ヘッドケース36は、サスペンシ ョン37の先端に固定されている。また、光ディスク1 20の記録層121として、ここでは相変化型の記録媒 体を用いる。

【0052】透明集光用媒体6は、例えば、屈折率n= 2. 0を有する重フリントガラスからなり、高さ0. 6 mm、長さ0. 9 mm、幅1. 8 mmを有する。この透 明集光用媒体6の被集光面6cは、浮上スライダ31の 一部を形成する。また、浮上スライダ31は、正圧を生 じる凸部31aと、負圧を生じる凹部31bを有し、両 者のバランスにより、100nm程度ないし、それ以下 の適当な浮上高を保つ。なお、浮上スライダ31の部材 120の基板122の材料としては、アルミニュウムだ 50 の屈折率が透明集光用媒体6の屈折率と等しい媒体で構

成し、浮上スライダ31の下面が、透明集光用媒体6の 被集光面6cを兼ねてもよい。

【0053】図15 (a), (b)は、この第11の実 施の形態に係る半導体レーザ活性媒体2を示す。同図 (a) は上面図、同図(b) は出力側の端面図である。 この半導体レーザ活性媒体2は、ビーム走査型のもので あり、基板460を有し、その上面に上部電極461、 下面に下部電極462、中央に活性層463をそれぞれ 形成し、活性層463の後端面に高反射膜465、先端 面に反射防止膜466を形成したものである。また、高 10 反射膜465と透明集光用媒体6の被集光面6c上の反 射透過膜7とで共振器を構成している。活性層463の 発振狭窄部の主部 4 6 4 a と先端部 4 6 4 b の幅はそれ ぞれ 3μ m、 5μ mであり、長さはそれぞれ 300μ m、50 μmである。上部電極461は、主部電極46 1aと、左右一対の先端部電極461b, 461bと、 光検出部電極461cからなる。活性層463の発振部 は、発振狭窄部464a、464bにより狭窄され、さ らに、先端部電極461b、461bに分割して、交互 に電流を流すことにより、出力レーザビームは左右に走 20 査される。この走査幅は約1μmで、走査周波数は30 MHzまで可能である。この出力レーザビームの走査 は、トラッキングの高周波部分に使用する。

【0054】図16は、このビーム走査型の半導体レーザ活性媒体2をトラッキングに使用した場合の、近接場光スポット9bとトラック8cの位置関係を示す。通常、光ディスク120では、100μm程度の偏心は避けることができない。このため、近接場光スポット9bを同図矢印方向(トラック方向に直交する方向)にトラッキングする必要がある。

【0055】図17は、サーボ特性を示す。トラック幅は 0.2μ m程度以下であり、その1/10以下のトラッキング精度が必要であり、また、高転送レート化のため6000 г р m以上の光ディスク120 の回転数が必要になることから、同図に示すように、利得80 d B以上、帯域30 k H 2 以上が必要となる。機械的なサーボのみでは、このような要求を満たすことができないので、10 k H 2 程度以上の高周波領域にレーザ光の走査を用いた2 段サーボにより、上記の要求を満たしている。また、光検出部電極461 c に逆バイアスを印加し 40 て光検出部電極461 c と下部電極462 との間の部分を光検出部として作動させることにより、信号再生を行う

【0056】活性層463の材料としては、AlGaInPを使用し、発振波長は630nmである。透明集光用媒体6の屈折率は2.0、NAは0.85であり、被集光面6c上での光スポット9aのスポットサイズは、式(2)から分かるように約0.2 μ mとなる。

【0057】次に、この光ディスク装置20の動作を説 導体レーザ活性媒体2としてビーム走査型のものを用い明する。光ディスク120は、モータ22によって所定 50 た場合は、開口10aの範囲内、すなわち0.1μm程

の回転速度で回転し、浮上スライダ31は、光ディスク120の回転によって生じる正 負圧とサスペンション37のバネによって光ディスク120上を浮上走行し、光ヘッド駆動系25により所定のトラック上をトラッキングする。信号処理系26による駆動によって半導体レーザの共振器を構成する反射遮光膜10の開口10aから近接場光スポット光9bが漏れ出し、この近接場光スポット光9bが光ディスク120の記録層121に伝播し、光記録が行われる。

【0058】再生に際しては、光ディスク120で反射 した光は、入射光の経路を逆に辿り、反射遮光膜10の 開口10aを通して半導体レーザ活性媒体2に入射し、 半導体レーザ活性媒体2を変調する。この半導体レーザ 活性媒体2の発振状態の変調は、光検出部電極461c と下部電極462との間の光検出部で検知され、光検出 部電極461cから検出信号として取り出される。信号 処理系26は、記録時には光検出部2xに入射した光デ ィスク120からの戻り光に基づいてトラッキング用の 誤差信号を生成してヘッド駆動系25を作動して、レー ザビーム3aとスイングアーム24を走査してトラッキ ングを行う。また、再生時には、光ディスク120の記 録層121に記録させない程度の低強度のレーザ光を出 射するように半導体レーザ活性媒体2を駆動し、光ディ スク1.20からの戻り光により誤差信号を生成する。 【0059】上記構成の光ディスク装置20によれば、

【0059】上記構成の光ディスク装置20によれば、 以下の効果が得られる。

(イ) 微細な記録マークの再生においても、変調度が大きく、かつ、歪みのない、従ってジッタの少ない再生信号が得られるため、再生時の解像度を大幅に上げることができ、光ディスクの大幅な高記録密度化が可能となる。

(ロ) 小型の光ヘッドが作製可能なため、高速のトラッキングが可能となる。

(ハ) 光スポット9 aの直径は0. 2μ mであり、約トラック幅は0. 2μ m、トラックピッチは0. 25μ m、グルーブ部の深さは、約0. 05μ mとした場合に、マーク長0. 1μ mの情報を記録および再生することができる。すなわち、従来の自己結合効果を用いた記録再生の場合に比べて5倍以上の高記録密度化が図れる。記録密度は約40Gbits/(inch)・であり、3. 57ンチディスクでは、約40GBの記録容量に相当し、従来の光ディスクの8倍以上に高記録密度化ができる。なお、光ヘッド1として他の実施の形態の光ヘッドを用いてもよい。

【0060】図18および図19は、本発明の第11の実施の形態に係る光ディスク装置を示す。反射遮光膜10の開口10aの形状は、図18に示すように、各辺が光スポット9aの直径よりも小さい矩形状でもよい。半導体レーザ活性媒体2としてビーム走査型のものを用いた場合は、関口10aの範囲内、またわた0、1、1、1

度の範囲内で近接場光スポット9 b の強度分布を左右に 動す。また、低周波側のトラッキングには、図19に示 すように、機械的サーボの他にピエゾ素子を用いる。

【0061】図20は、本発明の第13の実施の形態に 係る光ディスク装置20を示す。この光ディスク装置2 0は、第10の実施の形態の透明集光用媒体6を用いた 光ヘッド1を、5枚重ねのディスクスタック型の光ディ スク装置に適用したものであり、回転軸66によって回 転され、アルミニューム基板61の上下面に記録媒体6 2, 62がそれぞれ被着された5枚の光ディスク60 と、各光ディスク60の記録媒体62,62上を浮上走 行する10個の光ヘッド1と、回転軸63によって光へ ッド1を回転可能に支持するサスペンション64と、サ スペンション64を駆動する回転型リニアモータ65と を有する。一回転型リニアモータ65は、サスペンション 64が直結される可動片65aと、ヨーク65bによっ て連結され、可動片65aを駆動する電磁石65c,6 5 c とからなる。この光ヘッド1およびサスペンション 64の構造は、第10の実施の形態と同様である。この ように構成された第12の実施の形態によれば、光スポ 20 ット径も第10の実施の形態と同様であり、ディスク径 を3. 5インチとした場合、記録容量は400GBにで きる.なお、光ヘッドとして、第5~第8の実施の形態 の光ヘッドを使用してもよい。

【0062】図21は、本発明の第14の実施の形態に 係る光ヘッドの側面図を示す。この光ヘッド1は、第2 の実施の形態の対物レンズ4B、およびSILの透明集 光用媒体6をセルフォックレンズからなる透明集光用媒 体6に置き換えたものであり、他は第2の実施の形態と 同様に構成されている。なお、反射透過膜7の代わり に、第2の実施の形態に係る光ヘッドと同様に開口を有 する反射遮光膜を使用してもよい。

【0063】この第14の実施の形態によれば、半導体 レーザの共振器は、反射透過膜7と半導体レーザ活性媒 体2の後端面に形成された髙反射膜2dとから構成す る。これによって比較的光損失の少ない共振器が形成で きる。また、セルフォックレンズを透明集光用媒体6に 使用した場合、被集光面 6c でのスポット径は $1\sim 2\mu$ mと大きくなるが、この反射透過膜7で反射された光の 大半は共振器内に止まるため、光損失とはならない。ま 40 た、この反射透過膜7あるいは半導体レーザ活性媒体2 の後端面の高反射膜2dの反射率を調整することによ り、自己結合効果が大きくなるように半導体レーザの光 損失を調整することが可能となる。また、セルフォック レンズの場合、形状が円筒形であるため、支えやすく、 浮上スライダと一体化して光ヘッドを組み立てる上で好 都合である。

[0064]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光ヘッド および光ディスク装置によれば、記録媒体からの戻り光 50 光ディスク装置に適用した半導体レーザを示す図

を検出した信号の強度差が記録媒体の記録情報に応じて 大きくなるように反射透過膜が有する所定の透過率を設 定することにより、光スポット径を小さくしてもSN比 の高い再生信号が得られるので、半導体レーザの自己結 合効果を用いて信号を再生する場合に、再生信号のSN 比が高く、光ディスクの高記録密度化が可能となる。ま た、記録媒体からの戻り光を検出した信号の強度差が記 録媒体の記録情報に応じて大きくなるように反射反射膜 の開口のサイズを設定することにより、光スポット径を 10 小さくしてもSN比の高い再生信号が得られるので、半 導体レーザの自己結合効果を用いて信号を再生する場合 に、再生信号のSN比が高く、光ディスクの高記録密度 化が可能となる。また、本発明の光ヘッドおよび光ディ スク装置によれば、半導体レーザの共振器の出力面を記 録媒体に近接できるため、戻り光の位相が光素子の熱膨 張の影響を受けないため、使用温度範囲にわたって再生 出力の安定化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る光ヘッドに関 し、(a)は側面図、(b)は底面図

【図2】第1の実施の形態に係る半導体レーザ活性媒体 の構成を示す図

【図3】第1の実施の形態に係る注入電流と光出力の関 係を示す図

【図4】本発明の第2の実施の形態に係る光ヘッドに関 し、(a)は側面図、(b)は底面図、(c)は他の実 施の形態を示す底面図

【図5】本発明の第3の実施の形態に係る光ヘッドの側

30 【図6】本発明の第4の実施の形態に係る光ヘッドの側 面図

【図7】本発明の第5の実施の形態に係る光ヘッドの側 面図

【図8】本発明の第6の実施の形態に係る光ヘッドの側 面図

【図9】本発明の第7の実施の形態に係る光ヘッドの側 面図

【図10】本発明の第8の実施の形態に係る光ヘッドの 側面図

【図11】本発明の第9の実施の形態に係る光ヘッドの 側面図

【図12】(a), (b) は本発明の第10の実施の形 態に係る光ヘッドの断面図

【図13】本発明の第11の実施の形態に係る光ディス ク装置の斜視図

【図14】第11の実施の形態に係る光ディスク装置に 適用した光ヘッドに関し、(a)は側面図、(b)は底

【図15】(a), (b)は第11の実施の形態に係る

- 【図16】第11の実施の形態に係る光ディスク装置に おけるレーザ光とトラックの関係を示す図
- 【図17】第11の実施の形態に係る光ディスク装置におけるサーボ特性と2段サーボを示す図
- 【図18】本発明の第12の実施の形態に係る光ディスク装置におけるレーザ光とトラックの関係を示す図
- 【図19】第12の実施の形態に係る光ディスク装置に おけるサーボ特性と2段サーボを示す図
- 【図20】本発明の第13の実施の形態に係る光ディスク装置を示す側面図
- 【図21】本発明の第14の実施の形態に係る光ヘッド に関し、(a)は側面図、(b)は底面図である。
- 【図22】従来の光ヘッドを示す図
- 【図23】従来の光ヘッドの開口サイズに対する光出力の関係を示す図
- 【図24】従来の自己結合型レーザを搭載した浮上型光 ヘッドを示す図である。
- 【図25】従来のテーパー型ファイバを使用した自己結合型レーザを用いた光ヘッドを示す図である。

【符号の説明】

- 1 光ヘッド
- 2 半導体レーザ活性媒体
- 2a n型GaAs基板
- 2 b 活性層
- 2c p型GaAs層
- 2 d 高反射膜
- 2 e 反射防止膜
- 2 f 活性部電極
- 2g 光検出部電極
- 2 h n型電極
- 2 x 光検出部
- 3a, 3b, 3c レーザビーム
- 4 A コリメータレンズ
- 4 B 対物レンズ
- 5 フォールディングミラー
- 6 透明集光用媒体
- 6 a 入射面
- 6 b 反射面
- 6 c 被集光面
- 7 反射透過膜
- 8 光ディスク
- 8 a 記録媒体
- 8 b 基板
- 8 c トラック
- 9 a 光スポット
- 9 b 近接場光スポット
- 10 反射遮光膜
- 10a 開口
- 11 ホログラム
- 12 浮上スライダ

- 13 反射膜
- 20 光ディスク装置
- 22 モータ
- 23 リニアモータ
- 24 スイングアーム・
- 25 光ヘッド駆動系
- 26 信号処理系
- 31 浮上スライダ
- 3 1 a, 3 1 b 浮上スライダの部分
- 10 32 石英板
 - 35 光検出器
 - 36 ヘッドケース
 - 37 サスペンション
 - 50 光ヘッド
 - 51 半導体レーザ
 - 51a 高反射膜
 - 51b 反射防止膜
 - 52 ゴリメータレンズ
 - 53 セルフォックレンズ
- 20 54a 開口
 - 5 4 遮光膜
 - 55 ホトダイオード
 - 56 光ディスク
 - 56a 記録媒体
 - 57 光スポット
 - 60 光ディスク
 - 61 アルミニューム基板
 - 62 記録媒体
 - 63. 回転軸
- . 30 64 サスペンション
 - 65 回転型リニアモータ
 - 65a 可動片
 - 65b ヨーク
 - 65c 電磁石
 - 6 6 回転軸
 - 70 端面発光型半導体レーザ
 - 70a 半導体基板
 - 71 フォトダイオード
 - 72 支持基板
 - 40 73 プリズム
 - 74 対物レンズ
 - 7.5 ソリッドイマージョンレンズ
 - 75a 被集光面
 - 76 基板
 - 80 レーザ
 - 80a ミラー
 - 81 光検出器
 - 82 対物レンズ
 - 83 光ファイバ
- 50 84 テーパー部

8 5 先端

86 試料

120 光ディスク

121 記録層

122 アルミニウム基板

221 回転軸

460 基板

461c 光検出部電極

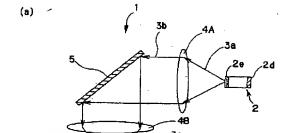
461a 主部電極

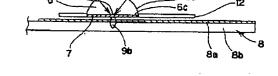
461 上部電極

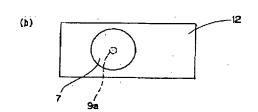
461c 電極

[図1]

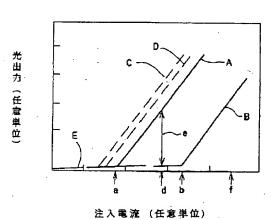
25







【図3】



462 下部電極

463 活性層

464a 主部

464b 先端部

465 高反射膜

466 反射防止膜

461b 先端部電極

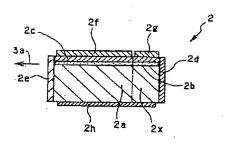
464a, 464b 発振狭窄部

Fl, F2 焦点

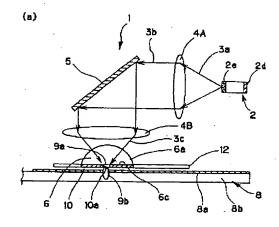
10 X トラック方向

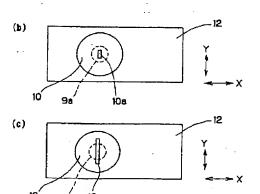
Y トラック方向に直交する方向

[図2]

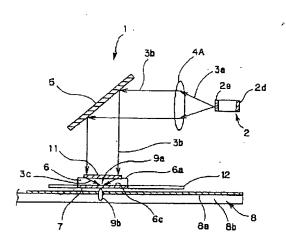


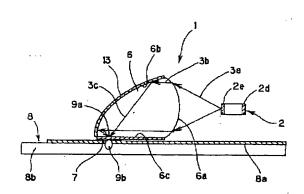
【図4】





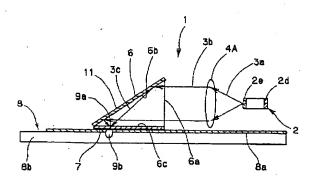
【図5】



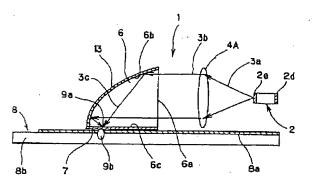


【図7】

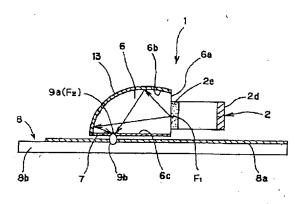
[図9]



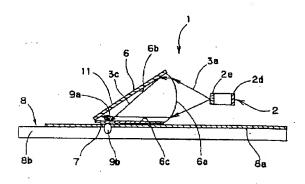
【図6】



【図8】

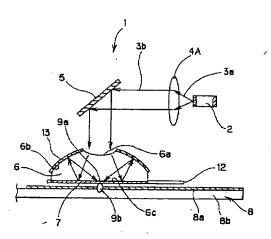


【図10】

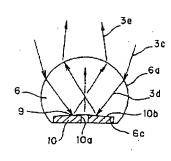


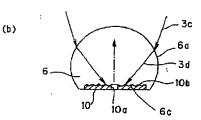
(a)

[図11]

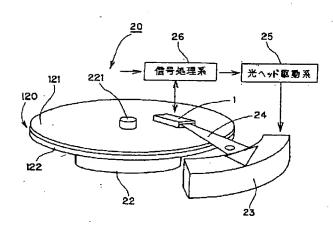


【図12】

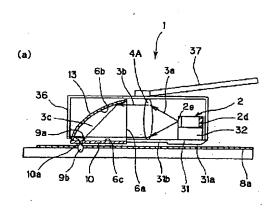




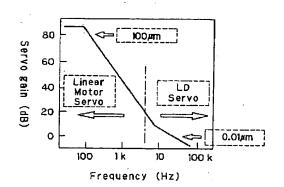
[図13]

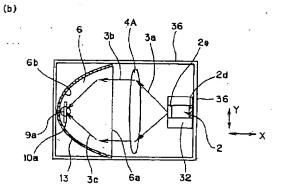


【図14】

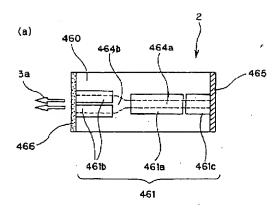


【図17】

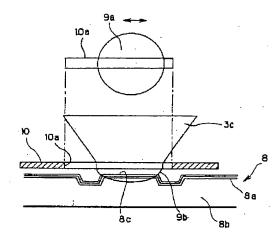


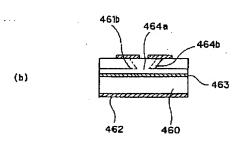


【図15】

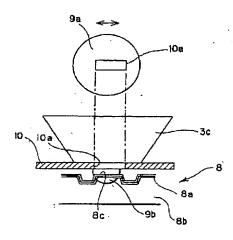


【図16】

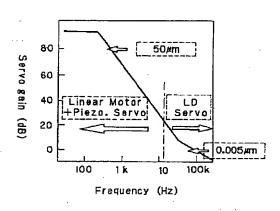




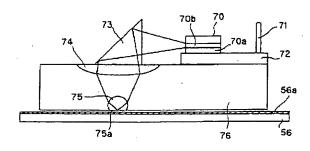
【図18】



【図19.】

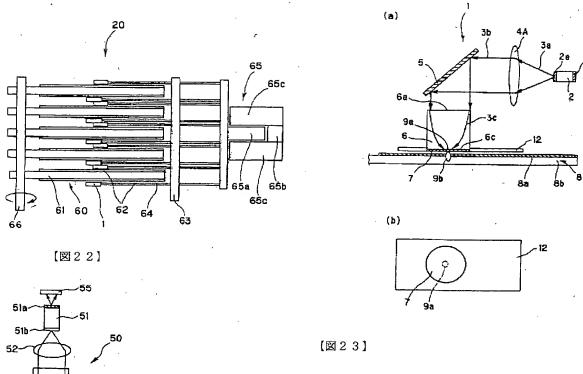


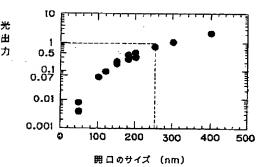
【図24】



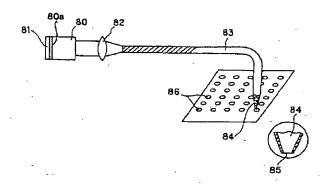








【図25】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別語	記号		FΙ				テーマコード(参考)
G 0 2 B	5/32		•	G 0 2 B	17/08		Α	5 D 1 1 9
	17/08		r	G 1 1 B	7/004		В	5 F O 4 9
G 1 1 B	7/004		·		7/125		В	5 F O 7 3
	7/125				7/13			5 F O 8 8
	7/13			H 0 1 S	5/028			
H01L	31/0232				5/14			
	31/10			G 0 2 B	1/10		Z	
H 0 1 S	5/028			H 0 1 L	31/02		D	
	5/14				31/10	4	A	
Fターム(参考)) 2H042 DA08 DB05	DD07 DE00						
1.	2H049 CA05 CA20)						
	9H087 KA13 TA01	TA03 TA06	•					

2H087 KA13 TA01 TA03 TA06

2K009 CC14 CC42 EE00

5D090 AA01 CC12 CC16 DD03 EE12

FF03 LL01 LL02

5D119 AA05 AA11 AA22 AA43 BA01

CA06 CA07 DA01 DA05 EA02

FA05 FA36 JA45 JA47 JA48

JA64 KA01

5F049 MA04 MB07 NA19 NB10 RA07

5F073 AA62 AA83 AB21 AB25 AB27

AB29 BA05 CA14 CB20 EA27

5F088 AA03 AB07 BA15 BB10 EA09

KA08